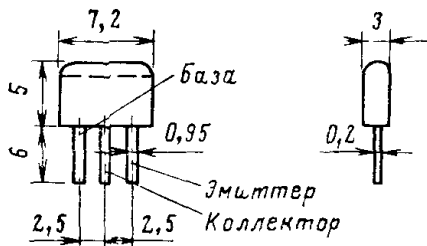


КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* уси-
тельные высокочастотные маломощные.



Предназначены для работы
в схемах усилителей высокой,
промежуточной и низкой час-
тоты

Выпускаются в пластмассо-
вом корпусе с гибкими выво-
дами Обозначение типа при-
водится на этикетке

Масса транзистора не более
0,18 г

Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_{\Sigma} = 5$ мА не менее

КТ315А, КТ315Б, КТ315Ж	15 В
КТ315В, КТ315Д, КТ315И	30 В
КТ315Г, КТ315Е	25 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 20$ мА,
 $I_B = 2$ мА не более

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г	0,4 В
КТ315Д, КТ315Е	1 В
КТ315Ж	0,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 20$ мА,
 $I_B = 2$ мА не более

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г	1,1 В
КТ315Д, КТ315Е	1,5 В
КТ315Ж	0,9 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим
эмиттером при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 1$ мА

КТ315А, КТ315В, КТ315Д	20 — 90
КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е	50 — 350
КТ315Ж	30 — 250
КТ315И не менее	30

Тостоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте
при $U_{КБ} = 10$ В, $I_{\Sigma} = 5$ мА не более

КТ315А	300 нс
КТ315Б, КТ315В, КТ315Г	500 нс
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж	1000 нс

Материал взят из источника:

Модуль коэффициента передачи тока при $U_{кэ} = 10$ В, $I_{к} = 1$ мА, $f = 100$ МГц не менее	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315И	2,5
КТ315Ж	1,5
Способность коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В не более	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315И	7 пФ
КТ315Ж	10 пФ
Входное сопротивление при $U_{кэ} = 10$ В, $I_{к} = 1$ мА не менее	40 Ом
Выходная проводимость при $U_{кэ} = 10$ В, $I_{к} = 1$ мА не более	0,3 мксм
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 10$ В не бо- лее	1 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 10$ кОм, $U_{кэ} =$ $= U_{кэ макс}$ не более	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е.	1 мкА
КТ315Ж	10 мкА
КТ315И	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{бэ} = 5$ В не более	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж	30 мкА
КТ315И	50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 10$ кОм	
КТ315А	25 В
КТ315Б	20 В
КТ315В, КТ315Д	40 В
КТ315Г, КТ315Е	35 В
КТ315Ж	15 В
КТ315И	60 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	6 В
Постоянный ток коллектора	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е	100 мА
КТ315Ж, КТ315И	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 213 - 298$ К	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е	150 мВт
КТ315Ж, КТ315И	100 мВт
Температура перехода	393 К
Температура окружающей среды	От 213 до 373 К

Материал взят из источника:

Примечания 1 Постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, при $T = 298 - 373$ К определяется по формуле

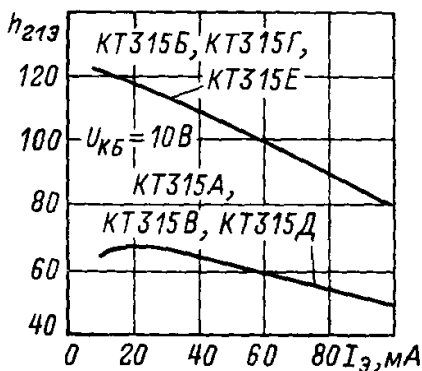
$$P_{K \text{ макс}} = (393 - T)/0,67$$

Допускается эксплуатация транзисторов в режиме $P_K = 250$ мВт при $U_{КБ} = 12,5$ В, $I_K = 20$ мА

2 Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 2 мм от корпуса транзистора

При включении транзистора в схему, находящуюся под напряжением, базовый вывод должен подсоединяться первым и отсоединяться последним

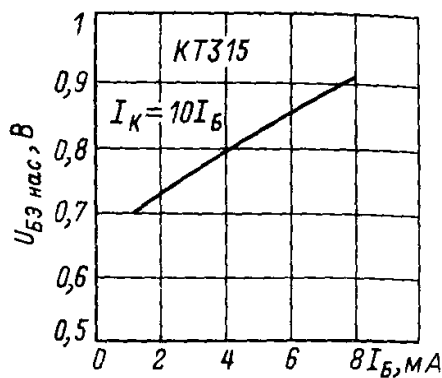
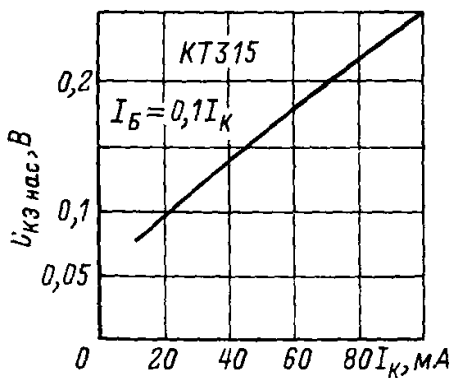
Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратными токами во всем интервале температур



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера

Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока базы



Материал взят из источника: